

T.YL491

Japanese translation of
Korean original document

第3回の審査(日本語訳)

KIM & CHANG
金・張 特許法律事務所

発送日付:2002.03.30

提出期限:2002.05.30

特許序 意見提出通知書

出願人 氏名 三菱電機株式会社
住所 日本国東京都千代田区丸の内二丁目2-3

代理人 氏名 張秀吉外2人
住所 ソウル市鍾路区内資洞219 ハヌリビル(金&張特許法律事務所)

出願番号 10-1998-0041271

発明の名称 半導体装置及びその製造方法

本出願に対する審査結果、以下のような拒絶理由があり特許法第63条の規定によりこれを通知するので、意見があるか補正を行う必要がある場合は上記期限までに意見書又は／及び補正書を提出されたい(上記期限について毎回1ヶ月単位で延長を申請することができ、この申請について別途の期間延長承認通知はしない)。

理由

本出願発明は、その出願日前に出願したもので、本出願後に出願公告された1998年特許出願第14850号(特許公告第1999-6403号公報参照)の出願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一のものと認められるので、(本出願の発明者がその出願前に出願した上記発明者と同一ではなく、且つ本出願時の出願人がその出願前に出願した上記特許出願の出願人と同一ではない)特許法第29条第3項の規定により特許を受けることができない。

記

本出願は半導体装置及びその製造方法に関するもので、特許請求範囲の請求項第3項は絶縁膜に形成された開口を導電体膜で埋め込み、絶縁膜上の導電体膜を化学的エッチングによって除去した後、絶縁膜を化学機械的研磨によって研磨し、平坦化することを特徴としているが、本願発明より先に出願された特許出願 1998-14850号(1998.4.25出願、1997.6.11国内優先権主張、1999.1.25公開、以下、引用出願という)

の最初の出願明細書または図面(特許出願1997-24146号参照)には絶縁層に形成されたコンタクトホールを導電層で埋め込んだ後、導電層を湿式乃至乾式方法によってエッチバック工程で食刻してコンタクトプラグを形成し、CMP工程でコンタクトプラグを含む絶縁層を平坦化する半導体素子のコンタクトプラグ形成方法が記載されているところ、本願発明と引用出願発明の構成を対比して見ると、本願発明の絶縁膜に形成された開口は引用出願の絶縁層に形成されたコンタクトホールに該当し、本願発明の導電体膜の化学的エッチングは引用出願の導電層の湿式または乾式食刻によるエッチバックに該当し、本願発明の絶縁膜の化学機械的研磨による平坦化は引用出願の CMP による絶縁層の平坦化に該当するので、本願の請求項第 3 項に記載された発明は引用出願の最初の出願明細書または図面に記載された発明と同一なものであると判断され、請求項第 3 項は特許法第 29 条第 3 項によって特許を受けることができない。

[添付]

添付 1 韓国特許公開 99-6403

2002年 3月 30日

特 許 庁 審査 4 局半導体 1 審査担当官室 審査官 グォン イン ヒ